

# IN-003:液晶TFTアレイ工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替

## 【削減方法】

- 液晶TFTアレイ工程のエッチング加工にてエッチングガスとして用いられる六フッ化硫黄(SF6)を主成分とするガスを、フッ化カルボニル(COF2)を主成分とするガスに切り替え、除害後のSF6ガスの放出を回避する。

## 【適用条件】

- ① エッチング加工で使用するガスを、SF6ガスからCOF2ガスに切り替えること
- ② プロジェクト実施後に製造品目やエッチング加工工程等で大幅な変更を行わないこと
- ③ プロジェクト実施前のSF6ガス使用量及びマザーガラスのエッチング加工枚数について、原則、プロジェクト実施前の1年間の累積値が把握可能であること

## 【ベースライン 排出量の考え方】

- COF2ガスへの代替を行わずにSF6ガスを使用してプロジェクト実施後と同じ量のマザーガラスを加工する場合に想定される温室効果ガス排出量。

## 【主なモニタリング項目】

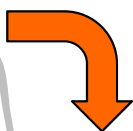
- プロジェクト実施後におけるマザーガラス加工枚数
- プロジェクト実施前におけるマザーガラス加工枚数及びSF6ガス使用量  
(原則、直近の1年間の当該値を基にベースラインの原単位を算定)

## 【方法論のイメージ】

### ベースライン



液晶TFTアレイ行程の  
エッチング工程にて  
SF6を使用



### プロジェクト実施後



COF2に代替  
することにより  
SF6の放出が回避される

